

半 导 体 学 报

第 12 卷 第 2 期 1991 年 2 月

目 录

- Si(113)表面的原子结构····· 邢益荣 张敬平 吴汲安 刘赤子 王昌衡 (65)
- Al/a-Si:H 界面反应和热处理行为光发射研究 ·····
·····钟战天 王大文 廖显伯 牟善明 范 越 李承芳 (68)
- 高压扩散结雪崩击穿参量的解析计算·····梁苏军 罗晋生 (73)
- 退火损伤对 Er 注入 GaAs 和 Yb 注入 InP 发光的影响 ·····
·····曹望和 张联苏 (80)
- As⁺ 沟道注入硅(100)的损伤、二次缺陷及载流子分布特征·····
·····张伯旭 罗 晏 王忠烈 (87)
- B⁺、P⁺ 离子注入 p-Si 中产生的缺陷及其退火特性的 DLTS 研究 ·····
·····孙璟兰 李名复 陈建新 (93)
- 一种二维 SOI CMOS 门级瞬态数值模型·····杜 敏 黄 澈 (101)
- GEDS 中的联机增量式设计规则检查及其实现·····应昌胜 洪先龙 王尔乾 (108)
- TiSi_x/GaAs 肖特基接触的退火特性·····钱 鹤 罗晋生 (114)
- 研究简报**
- GaAs/GaAlAs 多量子阱自电光效应光学双稳态·····
吴荣汉 段海龙 王启明 曾一平 孔梅影 潘 钟 张权生 林世鸣 (120)
- 研究快报**
- GaAs: Cr 中的 Cr⁴⁺(3d²) 态的光激发电子顺磁共振研究 ·····
·····毛晋昌 傅济时 吴 恩 秦国刚 王永鸿 马碧春 (125)